ハイブリッドペロブスカイト半導体における光学遷移: センターカチオン効果の定量的評価 Optical transitions in hybrid perovskite semiconductors: Quantitative analysis for the effect of center cation 岐阜大学 電気電子・情報工学科¹, 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター² ⁰加藤 雅人¹,藤関 健正¹,宮寺 哲彦²,杉田 武²,藤本 祥平¹, 近松 真之²,藤原 裕之¹ Gifu University¹, AIST² ^oM. Kato¹, T. Fujiseki¹, T. Miyadera², T. Sugita², S. Fujimoto¹, M. Chikamatsu², and H. Fujiwara¹ E-mail: fujiwara@gifu-u.ac.jp

【はじめに】有機無機ハイブリッドペロブスカイト半導体は、高い変換効率を有する低コスト太陽電池が実現可能な材料として注目されており、特にセンターカチオンとして、CH₃NH₃+ (MA⁺), HC(NH₂)₂+ (FA⁺)および Cs⁺を混合した材料において高い変換効率が報告されている¹⁾。これまでに 我々は、APbI₃型ペロブスカイト半導体の紫外・可視光吸収は、主に I5p 軌道の電荷分布によって 決定され、さらに I…H-N 水素結合による電荷密度分布の偏りが光吸収に大きな影響を与えるこ とを DFT 計算により明らかにした^{2,3)}。本研究では、APbI₃型ペロブスカイトにおいて、センター カチオンが光吸収に与える影響を定量的に評価することを試みた。

【計算方法】DFT 計算では、交換相関汎関数に PBE を用いた。また、APbI₃の A サイトに MA⁺, FA⁺, Cs⁺, NH₄⁺を導入した立方晶の結晶構造 ²⁾を仮定した。

【結果および考察】APbI₃の可視光吸収は、価電子帯の頂上(E = 0 eV)から 0.5 eV 程度下がったエ ネルギー領域の電荷分布により決定されている^{2.3}。図1は、このエネルギー領域における FAPbI₃ の電荷分布を示しており、図の a, b, c は、単位格子の a, b, c 軸に対応する。図の Q_{I,a}c は、このエ ネルギー領域における a-c 軸方向の各 I 原子の電荷量を示しており、特に電荷は、Q_{I,a} と Q_L が高 く Q_Lc は非常に小さい。さらに本研究では、Q_{Lac} が同じエネルギー領域の全電荷量に占める割合 (Q_I/Q_{Total})を算出した。また、APbI₃の光吸収を示す指標として、同じ価電子帯からの光学遷移に対 応する a-c 各軸方向の ϵ_2 値を求めた。図 2 は、各構造の Q_I/Q_{Total} と算出した各軸方向の ϵ_2 値を対応 させた結果を示しており、カチオンの種類ごとに Q_I/Q_{Total} が最も低くなる値を赤プロットにより 示している。図から分かるように、Q_I/Q_{Total} と ϵ_2 値は、非常によい線形性を示す。A サイトに FA⁺ を導入した場合は、I と N との距離が近く、さらに FA⁺に N 原子が 2 つ存在するため、センター カチオンと I 原子との相互作用により、c 軸の I 原子の電荷(Q_Lc)が減少する。その結果、FAPbI₃ は、 最も低い光吸収(ϵ_2 値)を示し、実験で確認されている FAPbI₃ における光吸収の低下を説明するこ とができる。一方、A サイトに Cs⁺を導入した場合は、センターカチオンと I 原子との相互作用が 極めて小さく、高い ϵ_2 値を示した。以上の結果から、これまでの理解とは異なり、センターカチ オンが光吸収に大きな影響を与えることを定量的に明らかにした。

1) Saliba et al., Energy Environ. Sci. 9, 1989 (2016), 2) Kato et al., arXiv:1605.05124 (2016), 3) 加藤他: 第 77 回応用物理学会秋季学術講演会 14a-A41-7 (2016).



Figure 1. Charge density profile of HC(NH₂)₂PbI₃.



Figure 2. ϵ_2 values in $APbI_3$ as a function of the valence charge ratio $Q_I \! / Q_{Total}.$